







	<h2 style="color: #D9534F;">SI7100DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7100DN-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7100DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 32715 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32715 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3810pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SI7100DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7100DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7100DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7100DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7060-B-03-IVR</b> Energy Micro (Silicon Labs) +/- 1C ACCURACY I2C TEMP SENSORS</p>	 <p><b>SI7101DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7100DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8</p>	 <p><b>SI7100DN</b> SI SI7100DN SI</p>
 <p><b>SI7101DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7102DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7102DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7060-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) SI7060 EVALUATION BOARD</p>

### SI7100DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI7100DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Komponenten</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Teil</a>
<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI7100DN-T1-GE3 Online bestellen</a>		

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited